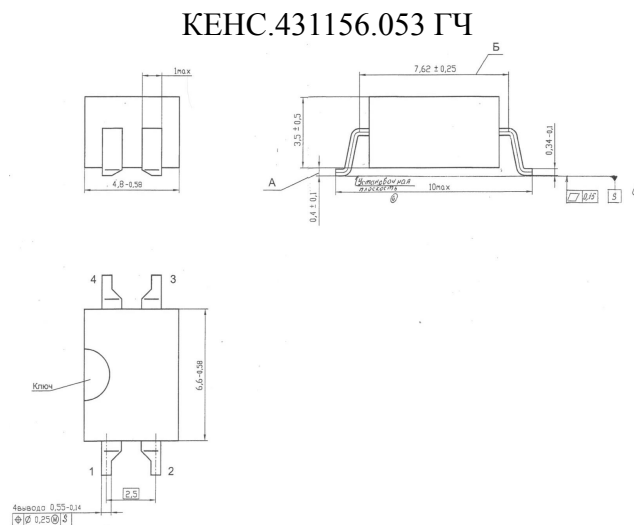


К449КП2АТ
АДБК.431160.901 ТУ

The figure consists of two parts. The left part is a detailed schematic of a two-stage CMOS inverter. It shows two PMOS transistors (top) and two NMOS transistors (bottom) connected in a cascaded fashion. The first stage's PMOS is connected to input 1 and output 3. The first stage's NMOS is connected to input 2 and output 4. The second stage's PMOS is connected to output 3 and output 4. The second stage's NMOS is connected to output 4 and output 3. The output of the first stage (output 3) is connected to the input of the second stage (input 1). The output of the second stage (output 4) is connected to the input of the first stage (input 2). The right part shows the equivalent circuit model. It consists of a voltage-controlled voltage source (represented by a diamond with a triangle inside) and a series capacitor. The input of the equivalent circuit is labeled 1 and 2, and the output is labeled 3 and 4.



№ вывода	Назначение
1	Анод с/д
2	Катод с/д
3	Выход коммутатора
4	Выход коммутатора

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма		Температура, °С
		не менее	не более	
Входное напряжение, В (при I _{вх} = 5 мА)	U _{вх}	1,1	1,5	25±10
			1,7	минус 45±3
			1,5	85±3
Напряжение изоляции, В	U _{из}	3000		25±10
Ток утечки на выходе в закрытом состоянии, мкА (при U _{ком} = ± 40 В, I _{вх} = 5 мА)	I _{ут.вых}		10	25±10 минус 45±3
			100	85±3
Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом (при I _{вх} = 0, I _{ком} = ± 220 мА)	R _{отк}		7	25±10 минус 45±3
			12	85±3
Проходная ёмкость, пФ (при F = 1 МГц)	C _{вых}		1,5	25±10
Время включения и выключения, мс (при I _{вх} = 5 мА, U _{ком} = 20В, C _н = 15пФ, R _н = 1 кОм, F _{вх.и} = 50 Гц, t _{вх.и} = 5мс)	t _{вкл}		2	25±10
	t _{выкл}		0,5	

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Наименование параметра (режим и условия измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма		Примечание
		не менее	не более	
Коммутируемое напряжение, В	U _{ком}	-40	40	
Входное обратное напряжение, В	U _{вх.обр}		3	
Входной ток, мА	I _{вх}	5	50	
Входной импульсный ток, А (при f = 100 Гц, Q = 0,1 %)	I _{вх.и}		1	
Коммутируемый ток (при температуре от минус 45°C до 35°C)	I _{ком}		220	1
Коммутируемый импульсный ток (одиночный импульс), мА (при t _и < 1 мс)	I _{ком.и}		350	
Максимальная рассеиваемая мощность, мВт	P _{рас}		330	
П р и м е ч а н и е : 1 Коммутируемый ток (I _{ком}) в диапазоне температур окружающей среды от 35°C до 85°C снижается линейно с коэффициентом 0,6 мА/°C				

Диапазон рабочих температур: от минус 40°C до 85°C. Изменение температуры среды: от минус 60°C до 100°C.

Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки и паяльником при температуре не выше 260°C.

Гарантийная наработка не менее 25 000 ч в пределах гарантийного срока хранения.

Интенсивность отказов в течение наработки не более $1 \cdot 10^{-6}$ 1/ч.

Гамма-процентный срок сохраняемости — 10 лет.

Обозначение микросхем при заказе и в конструкторской документации другой продукции:

Микросхема К449КП2АТ АДБК.431160.901 ТУ.

302040 РОССИЯ г. Орел, ул. Лескова, 19, АО «ПРОТОН»
Телефон: (4862) 49-85-43; Факс: (4862) 49-85-36; e-mail: sktb@proton-orel.ru